

3SJ11A

Pチャネルエンハンスメント形MOS電界効果トランジスタ P-Channel Enhancement
 高入力インピーダンス直流増幅用 MOS Field-Effect Transistor
 通信工業用 High Input Impedance DC Amplifier
 Industrial Use

3SJ11AはPチャネルエンハンスメントモードMOSFETで、MOS構造により高入力インピーダンスを示し、エンハンスメントモードであるためスイッチとしても応用が可能で、各種計測機器制御機器の高入力インピーダンス増幅およびアナログスイッチとして最適です。

○ゲートしゃ断電流が小さい。

Small I_{GSS} $I_{GSS} : -10 \text{ pA MAX. (} V_{GS} = -10 \text{ V)}$

○カットオフ電圧が低い。

Low cutoff voltage $V_{GS(off)} : -2.5 \text{ V TYP.}$

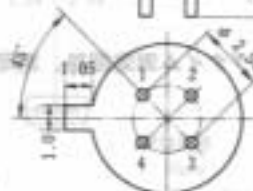
○オン抵抗が小さい。

Small $r_{DS(on)}$ $r_{DS(on)} : 170 \text{ } \Omega \text{ TYP.}$

外形図/PACKAGE DIMENSIONS
 (Unit : mm)



(実装部) 構造図 (単位: mm)



電極接続

1. Source
2. Gate
3. Drain
4. Sub. (Case)

EIAJ : TC-7, TB-9C
 JEDEC : TO-206MB, TO-72
 IEC : CL, B12

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$)

項目	略号	定数	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DS}	-30	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GS}	-40	V
ドレイン電流	I_D	-50	mA
全損失	P_T	225	mW
チャネル部温度	T_{ch}	100	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	$^\circ\text{C}$

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ゲートしゃ断電流	I_{GSS}	$V_{DS} = -10 \text{ V, } V_{GS} = V_{DS} = 0$			-10	μA
ドレイン漏れ電流	I_{DSS}	$V_{DS} = -10 \text{ V, } V_{GS} = V_{DS} = 0$			-10	nA
カットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = -10 \text{ V, } I_D = -10 \text{ } \mu\text{A, } V_{GS} = 0$	-1.5	-2.5	-3.5	V
オン抵抗	$r_{DS(on)}$	$V_{GS} = -10 \text{ V, } V_{DS} = -1.0 \text{ V, } V_{GS} = 0$		170	500	Ω
小信号順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS} = -10 \text{ V, } I_D = -1.0 \text{ mA}$	0.5	1.0		mS
小信号出力アドミタンス	$ y_{os} $	$V_{DS} = 0, f = 1.0 \text{ kHz}$		70		μS
小信号入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = -10 \text{ V, } V_{GS} = 0$		8.0		pF
小信号出力容量	C_{oss}	$V_{GS} = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$		3.5		pF